

電子デバイス研究会

〔委員長〕石原 宏（東工大）

〔幹事〕和田恭雄（早大）、益 一哉（東工大）、高橋琢二（東大）

日時 3月6日（木）14：00～17：00

3月7日（金）8：00～15：00

場所 NTT 水上「紫明荘」（群馬県利根郡水上町湯桧曾15-1 Tel：0278-72-3650，JR水上駅より湯桧曾行きバス10分，湯桧曾駅前下車）

協賛 超高速デバイスと関連技術調査専門委員会（委員長 中村 徹，幹事 佐藤文彦，榎木孝知，幹事補佐 原 直紀）

電子情報通信学会・電子デバイス研究会

議題 テーマ「超高速デバイスとその関連技術」

3月6日（木）午後 シリコン超高速デバイスと超40Gbps光伝送技術

EDD 03 32 14nm ゲート CMOS 技術

外園 明，大内和也，高柳万里子，渡辺由美，馬越俊幸，加藤善光，清水 敬
森 伸二，小熊英樹，佐々木俊行，吉村尚郎，宮野清孝，安武信昭，須藤裕之
安達甘奈，福井大伸，渡辺 健，玉置直樹，豊島義明，石内秀美
（東芝セミコンダクタ）

EDD 03 33 高性能ひずみ SOI-CMOS 素子技術

水野智久，杉山直治，手塚 勉，沼田敏典，前田辰郎，高木信一（MIRAI-ASET）

EDD 03 34 局所歪みチャネル技術による高駆動能力 55nm CMOS の作製

太田和伸（三菱電機）

EDD 03 35 高性能 SiGe HBT/微細 CMOS 混載化デバイス技術とその 40Gb/s 光通信用 LSI への応用

和田真一郎，橋本 尚，野中祐介，斉藤朋広，笹原郷子，富成達也，
酒井弘毅，徳永和朗，藤原 剛，神保智子，鷲尾勝由，細江英之（日立）
有働 勉（日立超 LSI システムズ）

EDD 03 36 InP HEMT を用いた 100-Gbit/s 論理 IC

村田浩一，佐野公一，北林博人，杉谷未広，菅原裕彦，榎木孝知（NTT）

3月7日（金）午前 高周波パワーデバイス，結晶成長（1）

EDD 03 37 携帯電話用 Si パワー-MOSFET 技術の開発動向

森川正敏，吉田 功（日立）

EDD 03 38 低オン抵抗トレンチ横型パワー-MOSFET を内蔵したスマートパワー-IC 技術

澤田睦美，岩谷将伸，田淵勝也，梶原里美，望月邦雄，藤島直人（富士電機総研）

EDD 03 39 高出力 GaAs/InGaP 複合チャネル FET

中田 健，増山竜二，中島 成（住友電工）

EDD 03 40 GaN系高出力ヘテロ接合 FET 技術

安藤裕二，宮本広信，岡本康宏，井上 隆，笠原健資，中山達峰，葛原正明（NEC）

EDD 03 41 高電圧動作による AlGaIn/GaN HEMT の相互変調歪プロファイル改善

長原正樹（富士通カンタムデバイス），吉川俊英（富士通研究所）
安達信雄，館野泰範，加藤真一，横山満徳，横川 茂（富士通カンタムデバイス）
木村徳治（富士通研究所），山口泰弘（富士通カンタムデバイス）
原直紀，常信和清（富士通研究所）

3月7日（金）午後 高周波パワーデバイス，結晶成長（2）

EDD 03 42 高バイアス AlGaIn/GaN HEMT の自己発熱評価

重川直輝，小野寺清光，塩島謙次（NTT）

EDD 03 43 大気圧成長GaN系MOCVD成長技術の開発

松本 功(日本酸素)

6日の研究会終了後、懇親会を開催いたします。奮ってご参加下さい。

参加申し込み 榎木 孝知(NTTフォトニクス研究所)

(e-mail: tenoki@aecl.ntt.co.jp, Tel 046-240-2796, Fax 046-240-2872)

2月11日(火)が参加申込一次締切です。お早目にお申込み下さい。

参加費 15,000円程度(資料代:会員1,900円,非会員2,500円,宿泊・食事代:13,000円)